

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H01G 4/30	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/44797 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 27. November 1997 (27.11.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00914 (22) Internationales Anmeldedatum: 5. Mai 1997 (05.05.97) (30) Prioritätsdaten: 196 20 434.8 21. Mai 1996 (21.05.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRUCHHAUS, Rainer [DE/DE]; Simrockstrasse 25, D-80997 München (DE). PITZER, Dana [DE/DE]; Hans-Fallada-Strasse 5, D-85716 Unterschleißheim (DE). PRIMIG, Robert [AT/DE]; En- tenbachstrasse 37, D-81541 München (DE). WERSING, Wolfram [DE/DE]; Weidenweg 14, D-85551 Kirchheim (DE). HÖNLEIN, Wolfgang [DE/DE]; Parkstrasse 8A, D-82008 Unterhaching (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, JP, KR, MX, RU, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	

(54) Title: THIN-FILM MULTILAYER CONDENSER

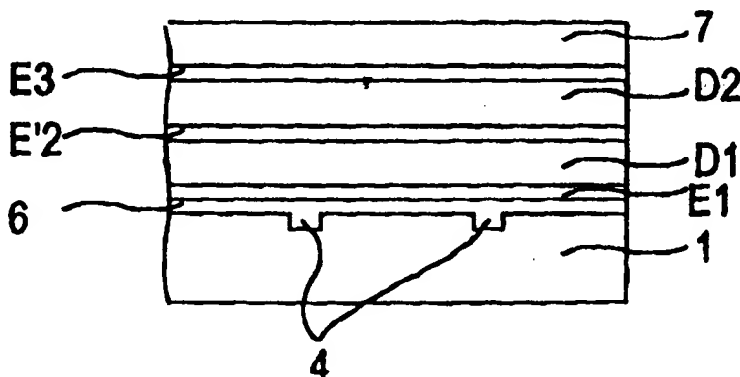
(54) Bezeichnung: DÜNNFILM MEHRSCHICHTKONDENSATOR

(57) Abstract

This invention concerns a multilayer condenser with thin-layer construction with increased capacitance and/or reduced space requirement, the dielectric layers of which are arranged alternately between electrode layers on a substrate. By means of alternating electrode layer bonding, parallel interconnexion of the individual condenser layers is achieved. Thus, the individual capacitances are summed, while the temperature behavior can be optimized by a suitable selection or combination of differing dielectric layers.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Mehrschichtkondensator in Dünnschichtbauweise mit erhöhter Kapazität und/oder verringertem Platzbedarf vorgeschlagen, dessen dielektrische Schichten alternierend zwischen Elektrodenschichten auf einem Substrat angeordnet sind. Durch ebenfalls alternierende Kontaktierung der Elektrodenschicht wird eine Parallelverschaltung der einzelnen Kondensatorschichten erzielt. Auf diese Weise addieren sich die Einzelkapazitäten, während das Temperaturverhalten durch geeignete Auswahl oder Kombination auch unterschiedlicher dielektrischer Schichten optimiert werden kann.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

7

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	IU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NI	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Beschreibung

DÜNNFILM MEHRSCHICHTKONDENSATOR

5

Bekannte Mehrschichtkondensatoren sind keramische Bauelemente, bei denen abwechselnd Elektrodenschichten und dünne keramische Schichten übereinander angeordnet sind. Je eine keramische Schicht mit den beiden benachbarten Elektrodenschichten bildet dabei einen Einzelkondensator. Die einzelnen Kondensatoren sind durch entsprechende Kontaktierung der Elektrodenschichten elektrisch parallel geschaltet. Zur Herstellung solcher keramischer Mehrschichtkondensatoren werden „nasse“ Verfahren verwendet, wobei zum Beispiel Grünfolien mit Hilfe eines Schlickers oder eines Sol-Gel-Verfahrens hergestellt und dann mit Elektrodenmaterial bedruckt werden. Durch Übereinanderstapeln solcher bedruckter Grünfolien und gemeinsames Sintern werden kompakte Bauelemente erhalten, die in einem letzten Verfahrensschritt noch mit elektrischen Anschlüssen versehen werden.

Zur Steigerung der Kapazität solcher keramischer Vielschichtkondensatoren kann die Anzahl der Einzelkondensatoren, also die Anzahl der Schichten des Mehrschichtkondensators erhöht werden. Mehrschichtkondensatoren mit hoher Kapazität im Bereich einiger μF sind auf diese Art und Weise aber nur mit hohem fertigungstechnischem Aufwand zu realisieren.

Herkömmliche und bereits heute verfügbare Elektrolytkondensatoren lassen sich zwar mit solch hohen Kapazitäten im Bereich einiger μF realisieren, besitzen jedoch oft unbefriedigende elektrische Eigenschaften. Insbesondere sind Elektrolytkondensatoren bezüglich des Frequenzgangs, des Schaltstromverhaltens (Innenwiderstand), des Leckstroms und des Temperaturbereichs, in dem sie einsetzbar sind, verbesserungsfähig. Desweiteren lassen sich mit Elektrolytkondensatoren keine ex-

trem flachen Bauformen, wie sie insbesondere für die SMD-Technik erforderlich sind, realisieren.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Mehrschichtkondensatoren mit hoher Kapazität anzugeben, die sich in flacher Bauform realisieren lassen, deren Herstellaufwand gegenüber bekannten Mehrschichtkondensatoren reduziert ist und deren elektrische Eigenschaften gegenüber Elektrolytkondensatoren verbessert sind.

10

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Mehrschichtkondensator nach Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein Verfahren zur Herstellung des Mehrschichtkondensators sind weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

15

Erfindungsgemäß umfaßt der Mehrschichtkondensator einen auf einem Substrat angeordneten Mehrschichtaufbau, in dem alternierend Elektrodenschichten und dielektrische Schichten jeweils als Dünnschicht übereinander angeordnet sind. Die Elektrodenschichten sind alternierend mit einer ersten und einer zweiten Kontaktschicht verbunden, die jeweils seitlich entlang des Schichtaufbaus und annähernd vertikal zu den Schichtebenen angeordnet ist. Die Anzahl n der dielektrischen Schichten wird größer als 1 und kleiner als 100 gewählt. Sie liegt vorzugsweise bei 5 bis 20 Schichten.

Die keramischen dielektrischen Schichten, die mit herkömmlichen Dünnschichtverfahren aufgebracht sind, besitzen eine maximale Schichtdicke von ca. 1 μm . Gegenüber bekannten naßkeramisch hergestellten Vielschichtkondensatoren, deren dielektrische Schichten im besten Fall auf etwa 5 μm Dicke reduziert werden können, bedeutet dies mindestens eine Schichtdickenverringerung um den Faktor 5. Da mit bekannten Dünnschichtverfahren aber bereits heute geringe Schichtdicken von bis zu 0,1 μm sicher und reproduzierbar erreichbar sind, wird mit der Erfindung eine Schichtdickenreduzierung um bis zu

30

35

Faktor 50 möglich. Da andererseits die spezifische Kapazität (= Kapazität/Volumen) umgekehrt proportional zum Quadrat der Dicke der dielektrischen Schichten ist, läßt sich mit der Erfindung die spezifische Kapazität gegenüber den besten bekannten Vielschichtkondensatoren um bis zu Faktor 2500 steigern. Mit der Erfindung wird daher gegenüber bekannten keramischen Vielschichtkondensatoren ein Materialersparnis, und gegenüber allen anderen bekannten Kondensatoren eine wesentlich flachere Bauweise und ein wesentlich geringerer Raumbedarf bei zumindest gleichbleibender Kapazität erzielt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Elektrodenschichten alternierend aus zwei unterschiedlichen Elektrodenmaterialien ausgebildet, die auch ein unterschiedliches Oxidationspotential besitzen. Dieser Aufbau ist besonders günstig für das ebenfalls erfindungsgemäße Herstellverfahren des Mehrschichtkondensators, da es aufwendige photolithographische Schritte für die Strukturierung bzw. Kontaktierung der Elektrodenschichten mit erster und zweiter Kontaktschicht vermeidet.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die dielektrischen Schichten des Mehrschichtkondensators aus zumindest zwei unterschiedlichen dielektrischen Materialien ausgebildet. Auf diese Weise ist es möglich, die elektrischen Eigenschaften des Mehrschichtkondensators durch Auswahl mehrerer geeigneter dielektrischer Materialien einem gewünschten Profil exakt anzupassen. So kann insbesondere das Temperaturverhalten bzw. die Temperaturcharakteristik der elektrischen Werte des Mehrschichtkondensators, der sogenannte Temperaturgang des Kondensators, eingestellt werden. Da das Temperaturverhalten neben der absoluten Höhe der Kondensatorkapazität von hoher Bedeutung für die Verwendbarkeit des Mehrschichtkondensators als Bauelement in elektrischen und elektronischen Schaltungen ist, erschließt die Erfindung ein weites Anwendungsgebiet für erfindungsgemäße Mehrschichtkondensatoren. So ist es möglich, einzelne dielektrische Schichten aus

einem Material herzustellen, welches für sich allein eine schlechte Temperaturcharakteristik in einem 1-Schicht-Kondensator ergäbe. Entscheidend ist allein die Temperaturcharakteristik des gesamten Mehrschichtkondensators, die
5 sich bei der erfindungsgemäßen parallelen Verschaltung von Einzelschichtkondensatoren im Schichtaufbau als Mittelwert ergibt. Aus einzelnen dielektrischen Schichten, die in einem gegebenen Temperaturbereich eine große Änderung ihrer elektrischen Werte aufweisen, läßt sich durch geeignete Kombination
10 ein Temperaturverhalten mit minimalen Änderungen der elektrischen Werte im Mehrschichtkondensator zusammenstellen.

Besonders hohe Kapazitäten werden erhalten, wenn die dielektrischen Schichten paraelektrische Schichten sind, also ferroelektrische Materialien umfassen. Das besonders ungünstige
15 Temperaturverhalten einzelner ferroelektrischer oder paraelektrischer Schichten in 1-Schicht-Kondensatoren wird im erfindungsgemäßen Mehrschichtkondensator wie eben beschrieben besonders vorteilhafterweise ausgeglichen. Ferroelektrische
20 Schichten zeigen bei der Curie-Temperatur einen Übergang von ferroelektrischem zu paraelektrischem Verhalten. In einem Kondensator bewirkt dies eine extreme Änderung der elektrischen Eigenschaften bei der Curie-Temperatur. Für einen aus ferroelektrischen Schichten aufgebauten erfindungsgemäßen
25 Mehrschichtkondensator weist ein geeigneter Schichtaufbau daher mehrere ferroelektrische Materialien auf, deren Curie-Temperaturen gleichmäßig über den für eine Anwendung gewünschten gewünschten Temperaturbereich verteilt sind.

30 Die Dünnschichtverfahren, mit denen die ferroelektrischen bzw. dielektrischen Schichten des Mehrschichtkondensators erzeugt werden, erlauben eine einfache Variation der Zusammensetzung in den Komponenten, die für die Eigenschaften ausschlaggebend sind. Insbesondere durch Multi-Target-Sputtern
35 kann durch Austauschen der Targets, durch Abdecken von Targetoberflächen oder eleganter durch Änderung der Leistung an den Targets die Zusammensetzung der aufwachsenden dielektri-

schen oder ferroelektrischen Schichten von Schicht zu Schicht in einfacher Weise variiert werden.

Als dielektrische Schichten eignen sich prinzipiell alle dielektrischen Materialien, die mit Dünnschichtverfahren erzeugbar sind und deren dielektrische Eigenschaften aufgrund bekannter Gesetzmäßigkeiten und Abhängigkeiten im Mehrschichtkondensator die gewünschten Gesamteigenschaften ergeben. Für die Funktionsfähigkeit des Mehrschichtkondensators ist vor allem die Durchschlagsfestigkeit bei der gegebenen Schichtdicke gegenüber einer gewünschten Einsatzspannung von Bedeutung. Weiterhin muß eine ausreichend homogene Abscheidbarkeit gegeben sein, um im Schichtaufbau die Homogenität von Schicht zu Schicht zu gewährleisten. Inhomogenitäten könnten zu höheren Leckströmen und damit zur verminderten Brauchbarkeit des Mehrschichtkondensators führen. Entsprechende Materialien finden bereits bei herkömmlichen keramischen Mehrschichtkondensatoren Verwendung. Als Beispiel seien hier nur COG-Massen auf der Basis der Keramiksyste $\text{me BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$, $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ oder $\text{Zr}(\text{Sn}, \text{Ti})\text{O}_4$ und Massen für den Kondensator-Standard XR7 auf der Basis von BaTiO_3 oder Massen für den Standard Z5U auf der Basis von Relaxorferroelektrika genannt, wie zum Beispiel $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (=PMN). Der erfindungsgemäße Aufbau hat darüber hinaus den Vorteil, daß auch solche dielektrischen Materialien verwendet werden können, die in einem 1-Schicht-Kondensator an sich ungeeignet wären, im erfindungsgemäßen Mehrschichtkondensator aber zur Abrundung dessen Eigenschaften dienen können.

Als ferroelektrische Schichten eignen sich Kombinationen aus dem Materialsystem $(\text{Ba}_{1-u}\text{Sr}_u)\text{TiO}_3$, aus dem System $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Zr}_x)\text{O}_3$ oder aus Relaxorsystemen wie zum Beispiel $\text{Pb}[\text{Ti}_{1-x}(\text{Mg}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})_x]\text{O}_3$. Mit diesen Materialien sind standardisierte Temperaturcharakteristiken wie beispielsweise X7R oder Z5U gemäß dem CIA-Standard möglich. Für diese Materialien sind alle gebräuchliche Abscheidungsverfahren wie MOD, Sol-Gel, MOCVD oder Sputtern möglich.

Die Elektrodenschichten umfassen Elektrodenmaterialien, die die relativ hohen Prozeßtemperaturen bis ca. 600°C unbeschädigt überstehen. Geeignete Materialien sind beispielsweise
5 Platin, Iridium, Ruthenium, RuO_2 , SrRuO_3 oder $(\text{LaSr})\text{CoO}_3$. Auch die Elektrodenschichten werden mit Dünnschichtverfahren wie beispielsweise CVD oder durch Sputtern hergestellt. Auch Elektronenstrahlverdampfen ist geeignet. Aus den angegebenen Elektrodenmaterialien lassen sich Paare mit unterschiedlichem
10 Oxidationspotential zusammenstellen, wie sie im erfindungsgemäßen Herstellverfahren erforderlich sind. Die aus keramischen Verbindungen bestehenden Elektrodenmaterialien haben den Vorteil, daß sich bei ihnen besonders leicht durch Variation der Zusammensetzung das Oxidationspotential einstellen
15 läßt.

Im folgenden wird die Erfindung und insbesondere das erfindungsgemäße Herstellverfahren anhand von Ausführungsbeispielen und der dazugehörigen elf Figuren näher erläutert. Die
20 Figuren sind zur Erläuterung nur vereinfachend und in nicht maßstabsgetreuer, schematischer Darstellung ausgeführt.

Figur 1 zeigt ein verwendbares Substrat in der Draufsicht

25 Figur 2 zeigt einen Schichtaufbau im Querschnitt

Figuren 3 bis 9 zeigen verschiedene Verfahrensstufen bei der erfindungsgemäßen Herstellung der elektrischen Verschaltung,

30

Figur 10 zeigt Temperaturgänge für verschiedene Keramikzusammensetzungen und

Figur 11 zeigt den Temperaturgang eines erfindungsgemäßen Mehrschichtkondensators.
35

Allgemeines Prinzip zur Herstellung eines Mehrschichtkondensators:

Figuren 1 und 2: Es wird vorzugsweise ein kostengünstiges Substrat verwendet, beispielsweise Al_2O_3 , Silizium oder Glas. Möglich sind auch metallische Substrate. Das Substrat 1 ist mit einer herkömmlichen Haftvermittlerschicht 6 beschichtet, die sowohl ein homogenes Aufwachsen der ersten Elektroden- schicht E1 als auch eine gute Haftung derselben gewährlei- stet. Eine bekannte Haftvermittlerschicht für Glas ist bei- spielsweise Titanoxid TiO_2 .

Die Herstellung des Mehrschichtkondensators erfolgt vorzugs- weise auf einem großflächigen Substrat 1, welches zur Unter- stützung der späteren Zerteilung in die Einzelkondensatoren der gewünschten Grundfläche bereits ein Grabenmuster aus Ril- len oder Furchen aufweist. In der Figur 1 ist beispielhaft ein solches Muster aus horizontalen Gräben 2 und vertikalen Gräben 4 dargestellt, die die Substratoberfläche in Reihen 3 und Spalten 5 aufteilen. Vorzugsweise werden Substrate mit Standardformaten verwendet, beispielsweise im 8''-Nutzen, die für herkömmliche Dünnschichtabscheidungsrichtungen gut ge- eignet sind.

Figur 2 zeigt bereits den vollständigen Schichtaufbau anhand eines schematischen Querschnitts (siehe Linie F2 in Figur 1) durch das Substrat 1 parallel zu den horizontalen Gräben 2. Dargestellt ist ein Schichtaufbau mit einer ersten Elektro- denschicht E1 aus einem Elektrodenmaterial mit einem ersten Oxidationspotential. Vorzugsweise ist diese erste Elektroden- schicht E1 aus einem solchen Elektrodenmaterial ausgebildet, welches eine gute Haftung zum Substrat 1 bzw. zur Haftver- mittlerschicht 6 zeigt und sich außerdem homogen und mit mög- lichst ebener und glatter Oberfläche abscheiden läßt. Ein gut geeignetes Material für die ersten Elektroden- schicht E1 ist beispielsweise Platin.

- Darüber wurde eine erste dielektrische Schicht D1 abgeschieden, beispielsweise ebenfalls mit einem Dünnschichtverfahren. Als nächstes folgt die zweite Elektrodenschicht E'2 aus einem zweiten Elektrodenmaterial, das ein zweites Oxidationspotential besitzt, welches niedriger als das Oxidationspotential der ersten Elektrodenschicht E1 ist. Gut geeignete Kombinationen mit der ersten Pt-Elektrode E1 bilden zum Beispiel IR oder (LaSr) CoO₃. Als weitere Schichten folgen eine zweite dielektrische Schicht D2, die aus gleichem Material wie die erste dielektrische Schicht D1 besteht oder von dieser unterschiedlich ist. Darüber wird eine dritte Elektrodenschicht E3 erzeugt, die wieder aus dem ersten Elektrodenmaterial mit dem ersten Oxidationspotential besteht.
- Bei einem aus mehr als zwei dielektrischen Schichten bestehenden Schichtaufbau werden weitere dielektrische Schichten D und Elektrodenschichten E und E' in entsprechend alternierender Abfolge übereinander angeordnet. Obergrenze für die Anzahl n der dielektrischen Schichten ist einerseits die gegebenenfalls nachlassende Homogenität und andererseits der erhöhte Verfahrensaufwand, der sich nicht zuletzt in den Kosten niederschlägt.
- Abschließende Schicht auf dem Schichtaufbau ist eine Schutzschicht 7, die im Ausführungsbeispiel aus einem dielektrischen Material besteht.
- Anschließend werden die Substrate 1 mit dem darüber aufgetragenen Schichtaufbau entlang der horizontalen Gräben 2 in Kondensatorreihen 3 aufgeteilt. Zur Auftrennung des Schichtaufbaus kann als Abtragsmethode Ionenstrahlätzen verwendet werden. Das Substrat dagegen kann gesägt oder entlang der vertikalen Gräben 4 gebrochen werden.
- Figur 3 zeigt einen weiteren schematischen Querschnitt durch den Schichtaufbau. Die in der Figur nach oben weisende Fläche stellt eine Seitenfläche des Schichtaufbaus aus Figur 2 dar.

Im nächsten Schritt wird nun selektiv Elektrodenmaterial der Elektrodenschichten mit dem niedrigeren Oxidationspotential von der Oberfläche (= Seitenfläche des Schichtaufbaus) her entfernt. Aufgrund des unterschiedlichen Oxidationspotentials der beiden Elektrodenmaterialien gelingt die selektive Entfernung eines Teils der Elektrode mit dem niedrigeren Oxidationspotential durch einfaches naßchemisches Ätzen mit entsprechend starkem Ätzmittel. Figur 4a zeigt den Schichtaufbau nach dem Ätzschrift, bei dem durch Entfernen eines Teils der Elektrode E'2 eine Vertiefung 8 in der Seitenfläche entstanden ist.

Als alternative Methode zum selektiven Ätzen kann die Seitenfläche in einem, zusätzliche Metallionen (z.B. Elektrodenmaterial mit höherem Oxidationspotential) enthaltenden, Elektrolyten behandelt werden. Dabei geht durch einen entsprechenden Redoxprozeß das Elektrodenmaterial mit dem niedrigeren Oxidationspotential in Lösung, während über dem Elektrodenmaterial mit dem höheren Oxidationspotential eine Metallabscheidung 9 stattfindet. Figur 4b zeigt die Anordnung nach diesem Schritt.

Als nächstes wird die Vertiefung 8 mit Isolationsmaterial gefüllt, um die angeätzten Elektrodenschichten E'2 gegen den späteren elektrischen Kontakt zu isolieren. Vorzugsweise wird dazu auf der Seitenfläche ganzflächig eine Isolationsschicht 10 abgeschieden, die die Vertiefung 8 mit auffüllt. Die Figuren 5a und 5b zeigen die Anordnung nach diesem Schritt.

Durch gleichmäßiges Abtragen der Isolationsschicht 10 parallel zur Oberfläche (Seitenfläche), beispielsweise durch chemisch mechanisches Polieren (CMP), werden die Elektrodenschichten E1 und E3 mit dem höheren Oxidationspotential freigelegt. Die Elektrodenschicht E'2 mit dem niedrigeren Oxidationspotential ist nun in der Vertiefung 8 mit einem Streifen 11 aus Isolationsmaterial bedeckt und damit elektrisch isoliert.

- Zur Kontaktierung der Elektroden-schichten E1 und E3 wird auf der Oberfläche nun eine erste Kontaktschicht 12 aufgebracht. Diese kann eine aus Chrom und/oder Nickel bestehende Haftvermittlerschicht, eine gesputterte Diffusiossperrschicht aus Platin sowie solche weiteren Elektroden-schichten (zum Beispiel aus Gold) umfassen, die ein Anschließen durch Löten ermöglichen.
- 10 Im nächsten Schritt wird auf der Seitenfläche, die der Kontaktschicht 12 gegenüberliegt, aus den Elektroden-schichten E1 und E3 ein Teil des Elektrodenmaterials herausgelöst. Dies erfolgt in einfacher Weise durch anodisch unterstütztes elektrochemisches Ätzen, bei dem die Kontaktschicht 12 in einem
- 15 elektrolytischen Ätzbad mit der Anode verbunden wird. Figur 8 zeigt die Anordnung nach dem elektrolytischen Ätzen. Durch Entfernen des Elektrodenmaterials der Elektroden-schichten E1 und E3 von der Oberfläche her sind Vertiefungen 13 entstanden.
- 20 In analoger Weise werden diese Vertiefungen 13 nun ebenfalls mit Isolationsmaterial 14 befüllt, die Oberfläche der Elektroden-schicht E'2 durch chemisch mechanisches Polieren freigelegt und mit einer darüber abgeschiedenen zweiten Kontaktschicht 15 elektrisch leitend verbunden.
- 25 Die anhand der Figuren 3 bis 9 beschriebenen Verfahrensschritte können vorteilhafterweise für mehrere Kondensatorreihen 3 gleichzeitig durchgeführt werden. Vorzugsweise werden mehrere Kondensatorreihen dazu so übereinandergestapelt, daß sämtliche Seitenflächen der Kondensatorreihen eine gemeinsame Oberfläche bilden. Abschließend werden die Kondensatorreihen 3 durch Zerteilen entlang der Gräben 4 in die einzelnen Mehrschichtkondensatoren mit der gewünschten Grundfläche zerteilt.
- 30
- 35

Herstellung eines Mehrschichtkondensators mit dem Temperaturgang X7R:

Ein Mehrschichtkondensator mit dem Temperaturgang X7R nach
5 dem CIA-Standard läßt sich mit einem Schichtaufbau realisieren, dessen dielektrische Schichten D aus dem Materialsystem $(\text{Ba}_{1-u}\text{Sr}_u)\text{TiO}_3$ (= BST), oder aus dem System $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Zr}_x)\text{O}_3$ oder aus Relaxorsystemen wie zum Beispiel $\text{Pb}[\text{Ti}_{1-x}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x]\text{O}_3$ bestehen. Durch Variation der Zusammensetzung,
10 zung, das heißt durch Variation der Parameter u oder x werden im Schichtaufbau mehrere unterschiedliche dielektrische Schichten D1 bis Dn realisiert. Die Materialzusammensetzung der unterschiedlichen dielektrischen Schichten wird dabei so gewählt, daß die kritischen Temperaturbereiche der einzelnen
15 dielektrischen Schichten möglichst gleichmäßig über den zu beobachtenden Temperaturbereich verteilt sind, in dem der Mehrschichtkondensator definitionsgemäß das gewünschte Temperaturverhalten X7R zeigen soll. Die Figur 10 zeigt anhand des BST-Systems $(\text{Ba}_{1-u}\text{Sr}_u)\text{TiO}_3$, wie der Temperaturgang des Wertes ϵ_r
20 ϵ_r durch Variation des Parameters u über einen Temperaturbereich von über 160°C verändert werden kann. Stellvertretend sind sieben Meßkurven für unterschiedliche Parameter u angegeben, deren Maxima gleichmäßig über den dargestellten Temperaturbereich von - 50 bis + 110°C verteilt sind. Die Figur
25 soll nur exemplarisch zeigen, daß eine gleichmäßige Verteilung der Maxima möglich ist. Geeignete Zusammensetzungen für den angestrebten Standard X7R können auch mit BST-Zusammensetzungen mit anderem Barium/Strontium-Verhältnis oder anderen Stoffsystemen erzielt werden. Zur Feinabstimmung
30 ist es auch möglich, im Mehrschichtkondensator unterschiedliche Zusammensetzungen oder Stoffsysteme zu verwenden, wobei jedoch auch mehrere Schichten die gleiche Zusammensetzung aufweisen können. Der kritische Temperaturbereich einer einzelnen dielektrischen Schicht D ist dabei der Bereich, in dem
35 die größten relativen Eigenschaftsänderungen auftreten. Dieser kritische Bereich ist bei ferroelektrischen Schichten ein scharf definierter Temperaturbereich rund um die Curie-

Temperatur, bei Relaxorsystemen dagegen ein relativ breiter Bereich um den Punkt der ferroelektrischen Phasenumwandlung herum. Das Temperaturverhalten des kompletten Mehrschichtkondensators ergibt sich gewissermaßen als Mittelwert bzw. durch Überlagerung der entsprechenden Temperaturprofile der einzelnen dielektrischen Schichten und läßt sich so auf die gewünschten Spezifikationen für X7R einstellen.

Figur 11 zeigt den Temperaturgang eines erfindungsgemäßen Mehrschichtkondensators, der den Standard X7R erfüllt. Die Meßkurve für den Temperaturgang weist zwar noch die Maxima auf, die den Maxima der Meßkurven für die Einzelschichten entsprechen, jedoch wird insgesamt eine nur geringe Abweichung vom Mittelwert beobachtet, wie es vom Standard gefordert wird. Zwischen -55° und $+125^{\circ}\text{C}$ dürfen dafür die relativen Kapazitätsänderungen $\Delta C/C$ des Mehrschichtkondensators Werte von ± 15 Prozent erreichen.

Herstellung eines Mehrschichtkondensators mit dem Temperaturgang Y5V:

Ein Mehrschichtkondensator mit dem Temperaturgang Y5V kann in einfacher Weise aus Relaxormaterialien hergestellt werden, wobei sämtliche dielektrischen Schichten D aus dem gleichen Relaxormaterial bestehen können. Es kann dazu das im vorigen Ausführungsbeispiel angegebene Relaxorsystem eingesetzt werden. Zur Erfüllung des geforderten Temperaturgangs können die dielektrischen Schichten D auch aus unterschiedlichen Relaxormaterialien erzeugt werden, um etwa anstelle der Y5V Charakteristik des obengenannten Systems PMN-PT eine Z5V-Charakteristik zu erhalten. Die für den Standard geforderten relativen Kapazitätsänderungen $\Delta C/C$ des Mehrschichtkondensators dürfen für Y5V im Intervall von -30° bis $+85^{\circ}\text{C}$ maximal $+22\%/-82\%$, und für Z5V im Intervall von $+10^{\circ}$ bis 85°C $+22\%/-56\%$ betragen.

Herstellung eines Mehrschichtkondensators mit dem Temperaturgang COG:

Der Temperaturgang COG läßt sich erfindungsgemäß mit einem Mehrschichtkondensator realisieren, dessen Schichtaufbau im wesentlichen dielektrische Schichten D mit niedriger Permittivität ϵ_r umfaßt. Dies sind insbesondere nicht-ferroelektrische Materialien. Ein geeignetes Materialsystem zur Erfüllung dieses Standards ist beispielsweise (Sn, Zr)TiO₄ mit $\epsilon_r \approx 40$. Durch Variation des Kationenverhältnisses Sn/Zr lassen sich auch hier dielektrische Schichten mit unterschiedlichem Temperaturverhalten kombinieren, die im gesamten Mehrschichtkondensator im Ergebnis einen äußerst gleichmäßigen Temperaturgang mit nur geringen relativen und absoluten Eigenschaftsänderungen ergeben. Die Temperaturgangstoleranzen lassen sich hier, falls gewünscht, auch besser einstellen, als es der Standard COG erfordert. Für den Standard COG muß über den gesamten Betriebstemperaturbereich des Kondensators der Temperaturkoeffizient $TCE = \frac{d\epsilon}{\epsilon dT} = 0 \pm 30 \text{ ppm/K}$ betragen.

Der erfindungsgemäße Mehrschichtkondensator kann mit sehr großer Kapazität als Ersatz für Elektrolytkondensatoren dienen. Alternativ kann er als Kondensator mit geringem Platzbedarf oder mit geringer Bauhöhe eingesetzt werden, zum Beispiel zur Integration in Chipgehäusen oder zum Einbau in kontaktlose Chipkarten (smart cards). Gegenüber konventionellen keramischen Mehrschichtkondensatoren (multilayer capacitor) besitzt er bei vergleichbarer Schichtanzahl eine typischerweise 100 mal höhere spezifische Kapazität. Pro Quadratmillimeter Fläche einer dielektrischen Schicht mit $\epsilon = 500$ können typischerweise Kapazitäten von ca. 10 nF erzielt werden. Mit größer werdendem ϵ erhöht sich dieser Wert entsprechend.

Patentansprüche

1. Mehrschichtkondensator in Dünnschichtbauweise mit den folgenden Merkmalen

- 5
- auf einem Substrat (1) sind alternierend insgesamt $n+1$ Elektrodenschichten (E) und n dielektrische keramische Schichten (D) mit einer maximalen Schichtdicke von $2\mu\text{m}$ zu einem Schichtaufbau angeordnet,
 - 10 - eine erste (12) und eine zweite Kontaktschicht (15) sind getrennt voneinander seitlich des Schichtaufbaus und annähernd vertikal zu den Schichtebenen angeordnet,
 - die Elektrodenschichten (E) sind alternierend mit der ersten beziehungsweise mit der zweiten Kontaktschicht
 - 15 (15) elektrisch leitend verbunden
 - für die Anzahl n gilt: $1 < n < 100$.

2. Mehrschichtkondensator nach Anspruch 1, bei dem die mit der ersten Kontaktschicht (12) verbundenen

20 ersten Elektrodenschichten (E) aus einem anderen Elektroden-Material als die mit der zweiten Kontaktschicht (15) verbundenen zweiten Elektrodenschichten (E') bestehen, wobei auch das Oxidationspotential der beiden Elektroden-Materialien unterschiedlich ist.

25

3. Mehrschichtkondensator nach Anspruch 1 oder 2, bei dem jede der dielektrischen Schichten für sich aus einheitlichem dielektrischen Material besteht, die verschiedenen dielektrischen Schichten aber zumindest zwei unterschiedliche

30 dielektrische Materialien umfassen.

4. Mehrschichtkondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die dielektrischen Schichten (D) ferroelektrische Schichten umfassen.

35

5. Mehrschichtkondensator nach Anspruch 4,

bei dem der Schichtaufbau unterschiedliche ferroelektrische Schichten mit unterschiedlichem Temperaturverhalten umfaßt, die so ausgewählt sind, daß sich durch Mittelwertbildung ein gewünschtes Temperaturverhalten für den gesamten Mehrschicht-
5 kondensator ergibt.

6. Mehrschichtkondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem gilt $5 \leq n \leq 20$.

10 7. Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtkondensators mit den Schritten

- a) auf einem Substrat (1) wird eine erste Elektrodenschicht (E1) aufgebracht
- 15 b) auf der ersten Elektrodenschicht wird eine erste dielektrischen Schicht (D1) aufgebracht
- c) auf der ersten dielektrischen Schicht wird eine zweite Elektrodenschicht (E'2) aus einem von der ersten Elektrodenschicht unterschiedlichen Material aufgebracht
- 20 d) die Schritte b) und c) werden so oft wiederholt, bis eine gewünschte Anzahl von n dielektrischen Schichten (D) entstanden ist, wobei die Elektrodenschichten (E) alternierend aus erstem und zweitem Elektroden-Material bestehen und $1 < n < 100$
- 25 e) an einer ersten, annähernd vertikal zu den Schichtebenen stehenden Seitenfläche des auf dem Substrat (1) erzeugten Schichtaufbaus wird selektiv ein Teil des Elektroden-Materials (E') mit dem niedrigeren Oxidationspotential herausgelöst
- 30 f) die so entstandenen Vertiefungen (8) werden mit Isolationsmaterial (11) aufgefüllt
- g) an einer zweiten, von der ersten getrennten Seitenfläche des Schichtaufbaus wird selektiv das Elektroden-Material (E) mit dem höheren Oxidationspotential zum Teil herausgelöst
- 35 h) die so entstandenen Vertiefungen (13) werden mit Isolationsmaterial (14) aufgefüllt

i) auf den beiden Seitenflächen wird nach Schritt f) beziehungsweise nach Schritt h) je eine Kontaktschicht aufgebracht, die jeweils alle aus dem gleichen Elektroden-Material bestehenden Elektrodenschichten elektrisch leitend miteinander verbindet.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
bei dem das Herauslösen des Elektroden-Materials mit dem höheren Oxidationspotential durch elektrochemisches Ätzen erfolgt, wobei die entsprechenden im vorhergehenden Prozeßschritt elektrisch miteinander verbundenen Elektrodenschichten mit der Anode verbunden werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
bei dem das Herauslösen des Elektroden-Materials mit dem niedrigeren Oxidationspotential durch naßchemisches Ätzen erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
bei dem in einem Elektrolytbad Elektroden-Material stromlos über den Elektrodenschichten (E) mit dem höheren Oxidationspotential abgeschieden wird, wobei das Elektroden-Material (E') mit dem niedrigeren Oxidationspotential als Opferkathode dient und zum Teil herausgelöst wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
bei dem zum Auffüllen der Vertiefungen (8, 13) über den Seitenflächen jeweils ganzflächig eine Isolationsschicht aufgebracht wird, und die Isolationsschicht durch Abtragen parallel zur Seitenfläche soweit entfernt wird, bis die jeweils nicht zum Teil herausgelösten Elektrodenschichten freigelegt sind.

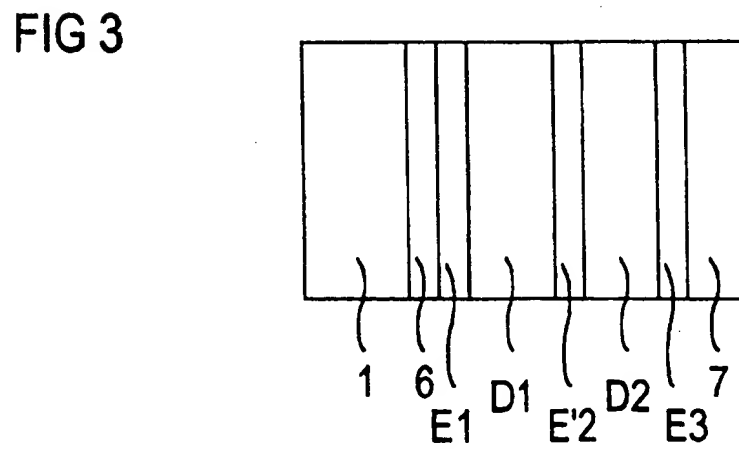
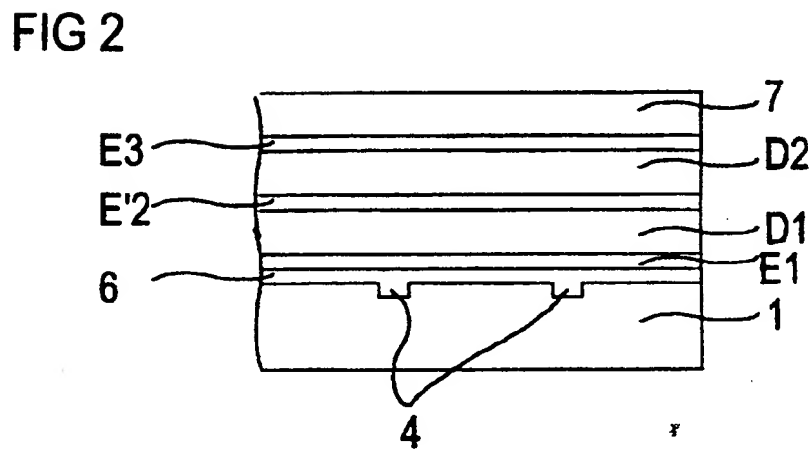
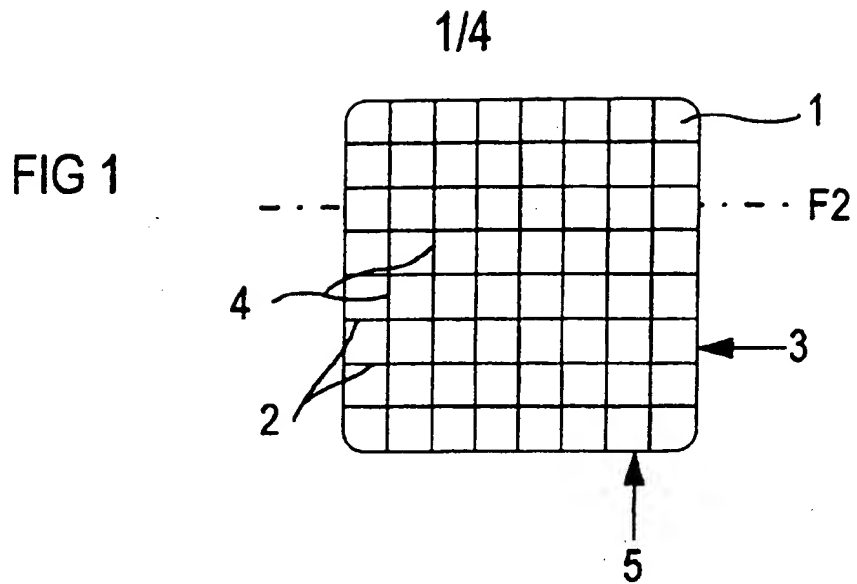
12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem das Abtragen der Isolationsschicht durch chemisch mechanisches Polieren erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12,

- bei dem ein großflächiges Substrat (1) verwendet wird,
- bei dem das Substrat nach Verfahrensschritt d) in streifen-
- 5 förmige Kondensatorreihen (3) zerteilt wird,
- bei dem mehrere der Kondensatorreihen übereinander in Richtung des Schichtaufbaus gestapelt werden
- bei dem die Verfahrensschritte e) bis i) im Stapel für mehrere Kondensatorreihen gleichzeitig durchgeführt werden
- 10 - bei dem die Kondensatorreihen abschließend wieder voneinander getrennt und weiter in die einzelnen Mehrschichtkondensatoren aufgeteilt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

- 15 bei dem ein Substrat (1) verwendet wird, welches zur Unterstützung der Zerteilung in Kondensatorreihen (3) und einzelne Mehrschichtkondensatoren in der Oberfläche ein der Aufteilung entsprechendes Grabenmuster (2, 4) aufweist.



2/4

FIG 4a

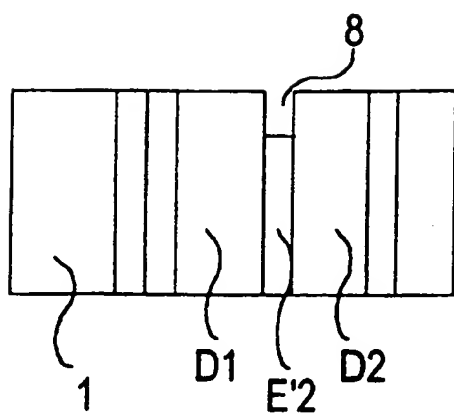


FIG 4b

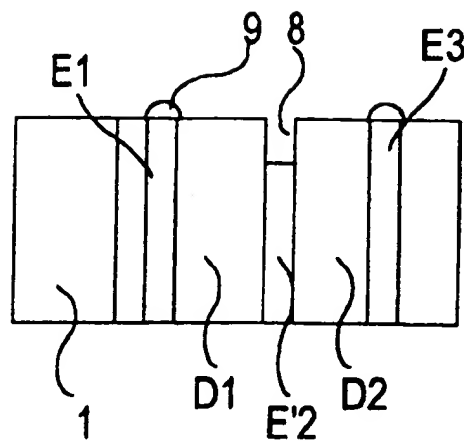


FIG 5a

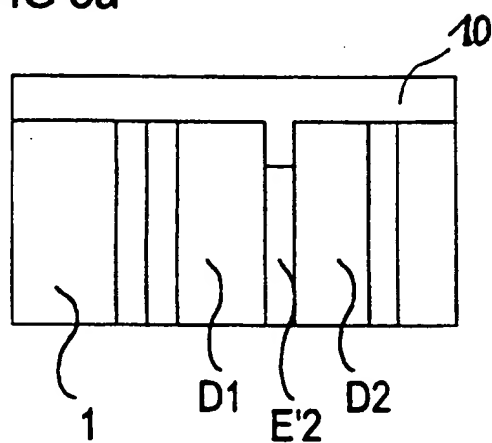


FIG 5b

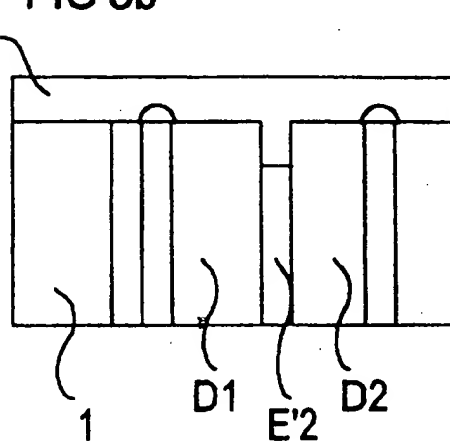
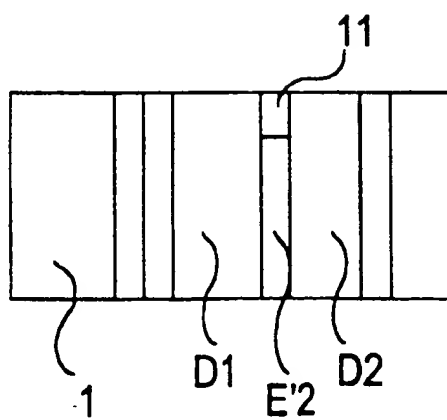


FIG 6



3/4

FIG 7

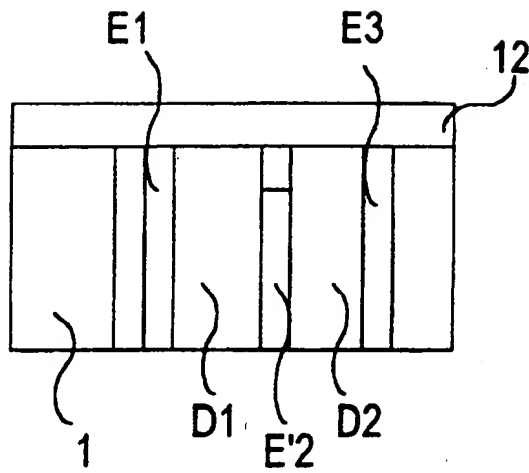


FIG 8

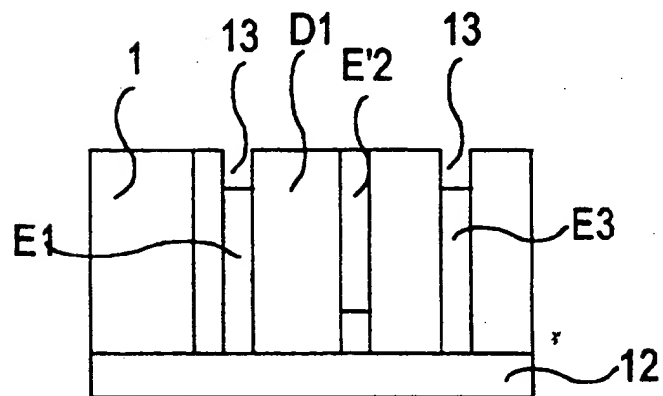
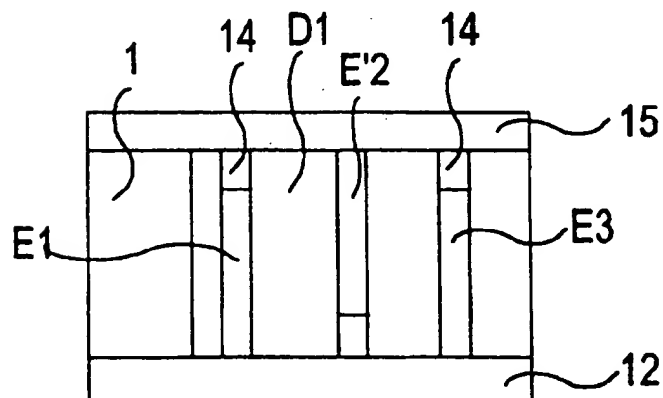


FIG 9



4/4

FIG 10

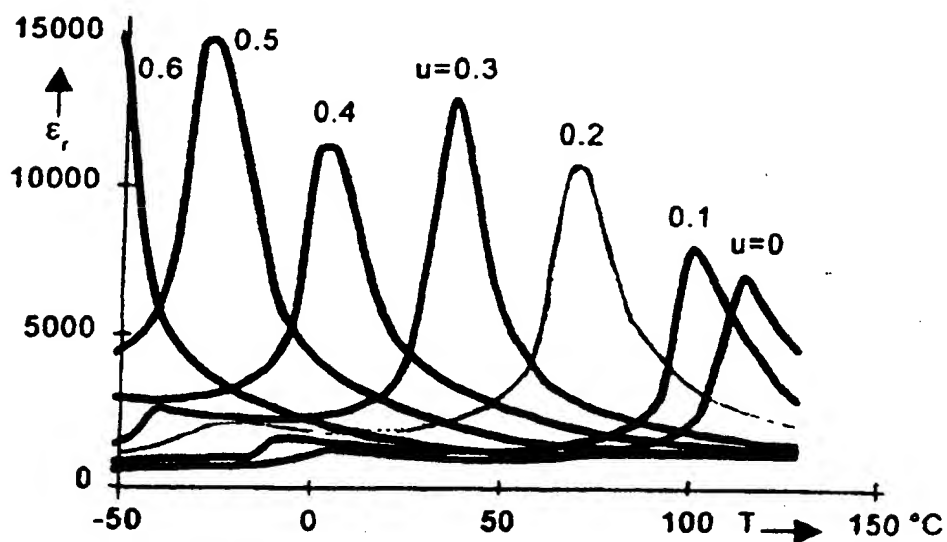
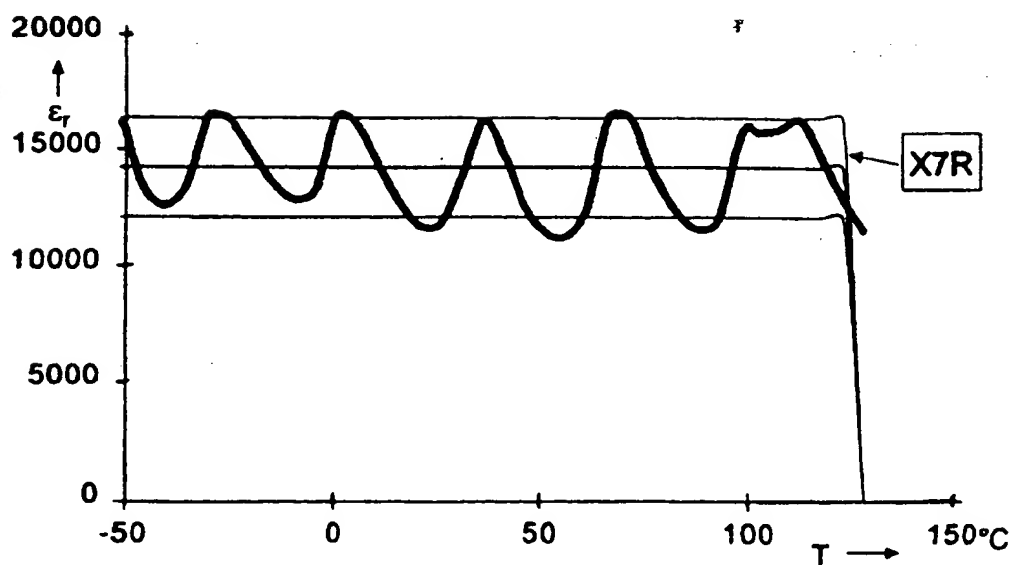
Mixed Crystal System $(\text{Ba}_{1-u}\text{Sr}_u)\text{TiO}_3$ (BST)

FIG 11



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: 1 Application No
PCT/DE 97/00914

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H01G4/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC:

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 H01G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of documents, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 43 00 808 A (SIEMENS AG) 17 March 1994 see column 1, line 68 - column 2, line 4 see column 2, line 7 - column 3, line 8 see column 3, line 47 - line 57 see claim 1 see figures 1-6	1,2,6
Y	---	3-5,7,9, 11
Y	EP 0 664 548 A (OXLEY DEVELOPMENTS CO., LTD.) 26 July 1995 see column 1, line 21 - line 29 see column 1, line 47 - line 56 see column 3, line 21 - line 24 see figures 1-3 ---	3-5
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- * A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- * E* earlier document but published on or after the international filing date
- * L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- * O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- * P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- * T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- * X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- * Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * &* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 September 1997

Date of mailing of the international search report

03 -10- 1997

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Goossens, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. J. Application No.
PCT/DE 97/00914

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 004, 30 April 1996 & JP 07 336118 A (MURATA MFG CO LTD), 22 December 1995, see abstract	7
Y	--- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 009, 31 October 1995 & JP 07 142288 A (ASAHI GLASS CO LTD), 2 June 1995, see abstract -----	9,11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: Application No
PCT/DE 97/00914

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4300808 A	17-03-94	EP 0606607 A JP 6283382 A US 5347696 A	20-07-94 07-10-94 20-09-94
EP 664548 A	26-07-95	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internat es Aktenzeichen

PCT/DE 97/00914

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H01G4/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 H01G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 43 00 808 A (SIEMENS AG) 17.März 1994 siehe Spalte 1, Zeile 68 - Spalte 2, Zeile 4 siehe Spalte 2, Zeile 7 - Spalte 3, Zeile 8 siehe Spalte 3, Zeile 47 - Zeile 57 siehe Anspruch 1 siehe Abbildungen 1-6	1,2,6
Y	---	3-5,7,9, 11
Y	EP 0 664 548 A (OXLEY DEVELOPMENTS CO., LTD.) 26.Juli 1995 siehe Spalte 1, Zeile 21 - Zeile 29 siehe Spalte 1, Zeile 47 - Zeile 56 siehe Spalte 3, Zeile 21 - Zeile 24 siehe Abbildungen 1-3 ---	3-5
	-/--	



Weitere Veröffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. September 1997

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03-10-1997

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Goossens, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internes Aktenzeichen

PCT/DE 97/00914

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 004, 30.April 1996 & JP 07 336118 A (MURATA MFG CO LTD), 22.Dezember 1995, siehe Zusammenfassung ---	7
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 009, 31.Oktober 1995 & JP 07 142288 A (ASAHI GLASS CO LTD), 2.Juni 1995, siehe Zusammenfassung -----	9,11

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat es Aktenzeichen

PCT/DE 97/00914

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4300808 A	17-03-94	EP 0606607 A	20-07-94
		JP 6283382 A	07-10-94
		US 5347696 A	20-09-94

EP 664548 A	26-07-95	KEINE	
